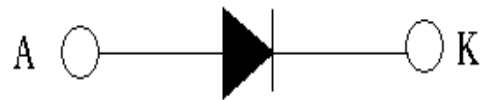


## 1、芯片特征

- (1) SIPOS 和 GPP 双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3)  $V_{RRM} \geq 800V/1000V$
- (4) 金属组合一：正面金属 AL+背面金属 Ti-Ni-Ag

## 2、芯片尺寸

- (1) 0.71mm\*0.71mm (28mil)



## 3、主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用

## 4、产品性能参数

参数名称	符号	单位	测试条件	ZL28	
				-08	-10
反复重复峰值电压	$V_{RRM}$	V	$T_j=25^\circ\text{C}$ , $I_{RRM}=5\ \mu\text{A}$	800	1000
正向平均电流	$I_F (AV)$	A	$V_{FM}=1V$	$\geq 0.5A$	
正向浪涌电流	$I_{FSM}$	A	$T_p=8.3ms$ , $\sin 180^\circ$ , $T_j=25^\circ\text{C}$	3.0	
结温范围	$T_j$	$^\circ\text{C}$		-40~150	

## 5、芯片结构

名称	符号	单位	尺寸
芯片尺寸	U	mm	$0.71 \pm 0.05$
沟槽尺寸	W	mm	$0.43 \pm 0.05$
金属尺寸	X	mm	$0.35 \pm 0.05$
芯片厚度	Y	$\mu\text{m}$	$230 \pm 10$
沟槽深度	Z	$\mu\text{m}$	$120 \pm 10$
AL 金属层厚度		$\mu\text{m}$	$7 \pm 1$
Ti-Ni-Ag		$\mu\text{m}$	$1.0 \sim 1.5$
Ni-Au 金属层厚度		$\mu\text{m}$	$0.5 \sim 0.75$